

8W单声道AB类全差分音频功率放大器

概要

CS8505E是AB类8.0W全差分单声道音频放大器。在电源电压为7.4V的情况下,CS8505E可以为4Ω的负载输出6.8W的功率。2.5~9.0V宽电压工作范围,快速的启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8505E成为双节锂电池串联供电或者是DC电源是9V的情况下最适用的音频功放。

CS8505E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8505E对RF噪声的抑制能力,并且省去了传统音频功放的BYPASS电容。

CS8505E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。

CS8505E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40°C至85°C。

描述

- 输出功率---AB类模式
 $V_{DD} = 8.5V, THD+N=10\%$
 $RL = 8\Omega \quad 4.00W$
 $RL = 4\Omega \quad 8.00W$
- $V_{DD} = 5.0V, THD+N=10\%$
 $RL = 8\Omega \quad 1.30W$
 $RL = 4\Omega \quad 3.00W$
- 工作电压范围:2.5~9.0V
- 优异的“噼噗-咔嚓”杂音抑制能力
- 高的电源抑制比(PSRR) : 在217Hz下为-80dB
- 快速的启动时间 (260ms)
- 低静态电流 (3mA)
- 低关断电流 (<0.1μA)
- 过流保护, 短路保护和过热保护
- 符合Rohs标准的无铅封装]

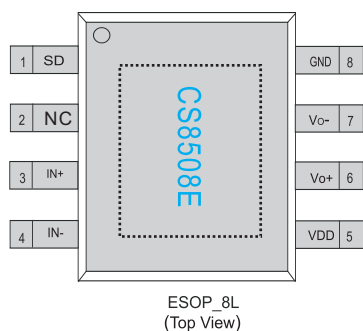
封装

- ESOP8L

应用:

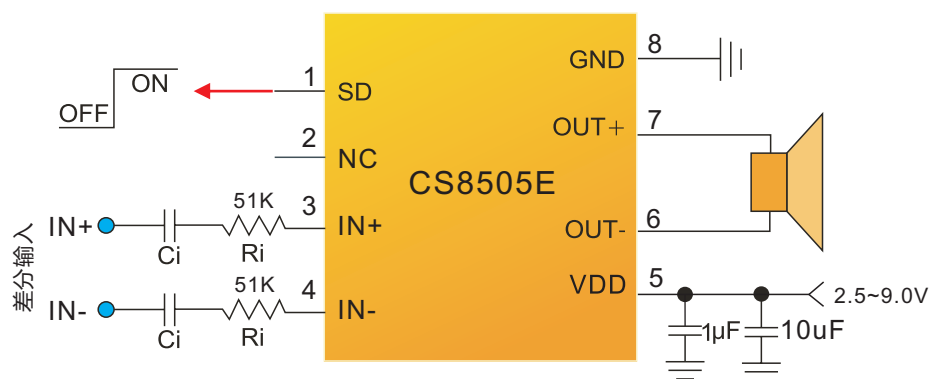
- 多媒体音箱
- 扩音器

引脚排列以及定义

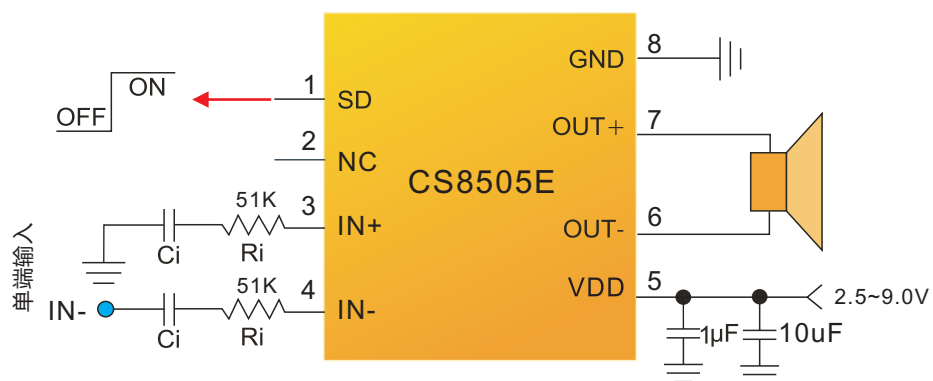


序号	符号	描述
1	SD	掉电控制管脚, 高电平有效
2	NC	空脚
3	IN+	音频输入正端
4	IN-	音频输入负端
5	VDD	电源
6	VO+	正相音频输出
7	VO-	反相音频输出
8	GND	地

典型应用图 (差分输入应用图)



典型应用图 (单端输入应用图)



极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V_{DD}	无信号输入时供电电源	12	V
V_I	输入电压	-0.3 to $V_{DD}+0.3$	V
T_J	结工作温度范围	-40 to 150	°C
T_{SDR}	引脚温度 (焊接10秒)	260	°C
T_{STG}	存储温度范围	-65 to 150	°C


推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V_{DD}	输入电压	2.5~9.0	V
T_A	环境温度范围	-40~85	°C
T_j	结温范围	-40~125	°C

热效应信息²

参数	描述	数值	单位
$\theta_{JA}(ESOP8)$	封装热阻---芯片到环境热阻	40	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装类型	数量
CS8505E	ESOP-8L		管装	100 units

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV
 ESD 范围MM(机器静电模式) ----- ±400V

- 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
- PCB板放置CS8505E的地方,需要有散热设计,使得CS8505E底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过过孔和地相连。

电气参数

T_A = 25°C (除非特殊说明)

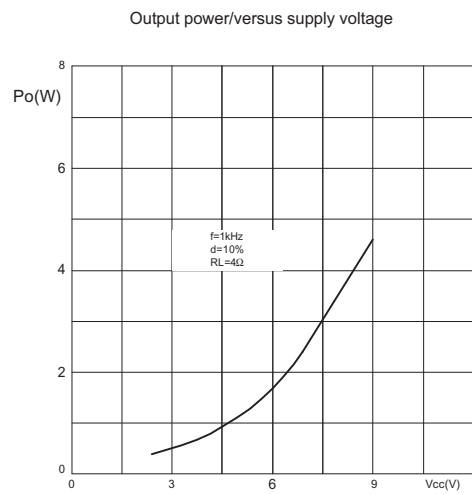
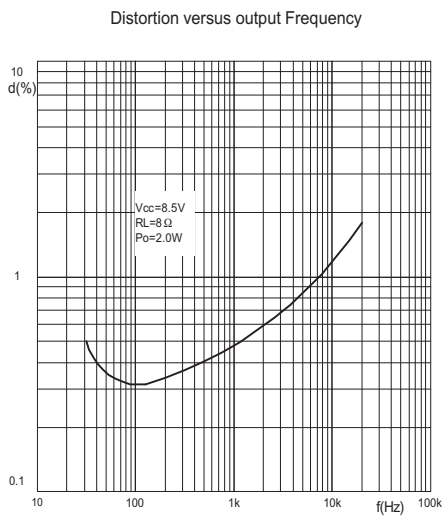
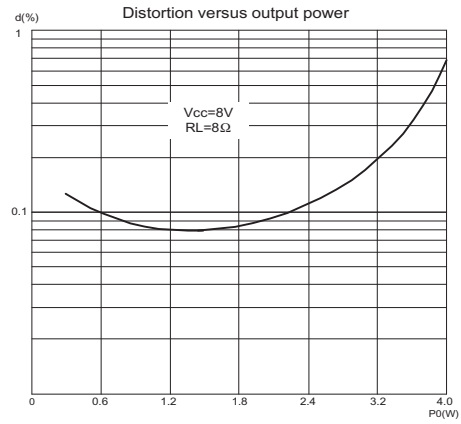
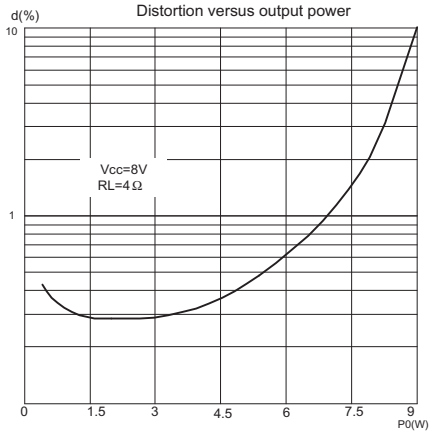
参数	描述	测试条件	最小	典型值	最大	单位
V _{OO}	输出失调电压	V _{IN} =0V, A _v =2V/V V _{DD} =2.5V to 9.0V		5	25	mV
PSRR	电源抑制比	V _{DD} =2.5V to 9.0V, 217Hz		-80		dB
CMRR	共模抑制比	输入管脚短接, V _{DD} =2.5V to 9.0V		-70		dB
I _{IH}	高电平输入电流	V _{DD} =9.0V, V _I =V _{DD}			50	μA
I _{IL}	低电平输入电流	V _{DD} =9.0V, V _I =0V		5		μA
I _{DD}	静态电流	V _{DD} =7.5V, 无负载, 无滤波		4.6		mA
		V _{DD} =3.6V, 无负载, 无滤波		2.5		
I _{SD}	关断电流			0.1		μA
	关断状态下输出阻抗	V _(SHUTDOWN) =0.35V		2		KΩ
Gain	放大倍数			$\frac{192k\Omega}{R_{in}}$		V/V
R _{SD}	SHUTDOWN 引脚下拉电阻			230		KΩ

工作特性

T_A=25°C, Gain = 2 V/V, R_L = 8 Ω (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
P _O	输出功率	V _{DD} =9.0V, THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω		9.00		W
		V _{DD} =9.0V, THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω		7.50		
		V _{DD} =7.4V, THD=10%, f=1KHz, R _L =8Ω		3.50		
		V _{DD} =7.4V, THD=1%, f=1KHz, R _L =8Ω		3.00		
		V _{DD} =7.4V, THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω		6.90		
		V _{DD} =7.4V, THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω		5.60		
		V _{DD} =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.56		
		V _{DD} =5.0V, THD=1%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.00		
		V _{DD} =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω		1.30		
		V _{DD} =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω		1.00		
		V _{DD} =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R _L =8Ω		0.70		
		V _{DD} =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R _L =8Ω		0.52		
THD+N	总谐波失真+噪声	V _{DD} =7.4V, P _O =1.0W, f=1KHz, R _L =8Ω		0.11		%
		V _{DD} =4.2V, P _O =0.4W, f=1KHz, R _L =8Ω		0.16		
		V _{DD} =3.6V, P _O =0.4W, f=1KHz, R _L =8Ω		0.15		
η	效率	V _{DD} =5.0V, P _O =0.6W, f=1KHz, R _L =8Ω		50		%
t _{ST}	启动时间			40		ms

典型特征曲线 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, Gain = 2 V/V, $R_L = 8\ \Omega$ (AB类模式, 除非特殊说明)



产品特性

CS8505E系列是一款AB类全差分音频功率放大器。9.0V电源下，能够向4Ω负载提供9.0W的输出功率。

CS8505E内置了过流保护，过热保护和欠压保护功能，这些功能保证了芯片在异常的工作条件下关断芯片，有效地保护了芯片不被损坏，当异常条件消除后，CS8505E有自恢复功能可以让芯片重新工作。

Pop & Click抑制

CS8505E系列内置专有的时序控制电路,实现全面的Pop & Click抑制,可以有效地消除系统在上电,下电,Wake up和Shutdown操作时可能会出现瞬态噪声。

保护电路

CS8505E在应用的过程中,当芯片发生输出管脚和电源或地短路,或者输出之间的短路故障时,过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后,CS8505E自动恢复工作。当芯片温度过高时,芯片也会被关断。温度下降后,CS8505E可以继续正常工作。当电源电压过低时,芯片也将被关断,电源电压恢复后,芯片会再次启动。

去耦电容 (C_s)

CS8505E是一款高性能音频放大器，电源端需要加适当的电源供电去耦电容来确保其高效率 and 最佳的总谐波失真。同时为得到良好的高频瞬态性能，希望电容的ESR值要尽量的小,一般选择典型值为1uF的电容旁路到地。去耦电容在布局上应该尽可能的靠近芯片的V_{DD}放置。把去耦电容放在与CS8505E较近的地方对于提高放大器的效率非常重要。因为器件和电容间的任何电阻或电感都会导致效率的降低。如果希望更好的滤掉低频噪声，则需要根据具体应用添加一个470uF或者更大的去耦

输入电阻 (R_{in})

通过设定输入电阻可以设定系统的放大倍数，如下式：

$$\text{Gain} = \frac{192 \text{ k}\Omega}{R_{in}} \left(\frac{V}{V} \right)$$

两个输入电阻之间的好匹配对提升芯片PSRR,CMRR以及THD等性能都有帮助，因此要求使用精度为1%的电阻。PCB布局时，电阻应紧靠CS8505E放置，可以防止噪声从高阻节点的引入。

输入电容(C_{in})

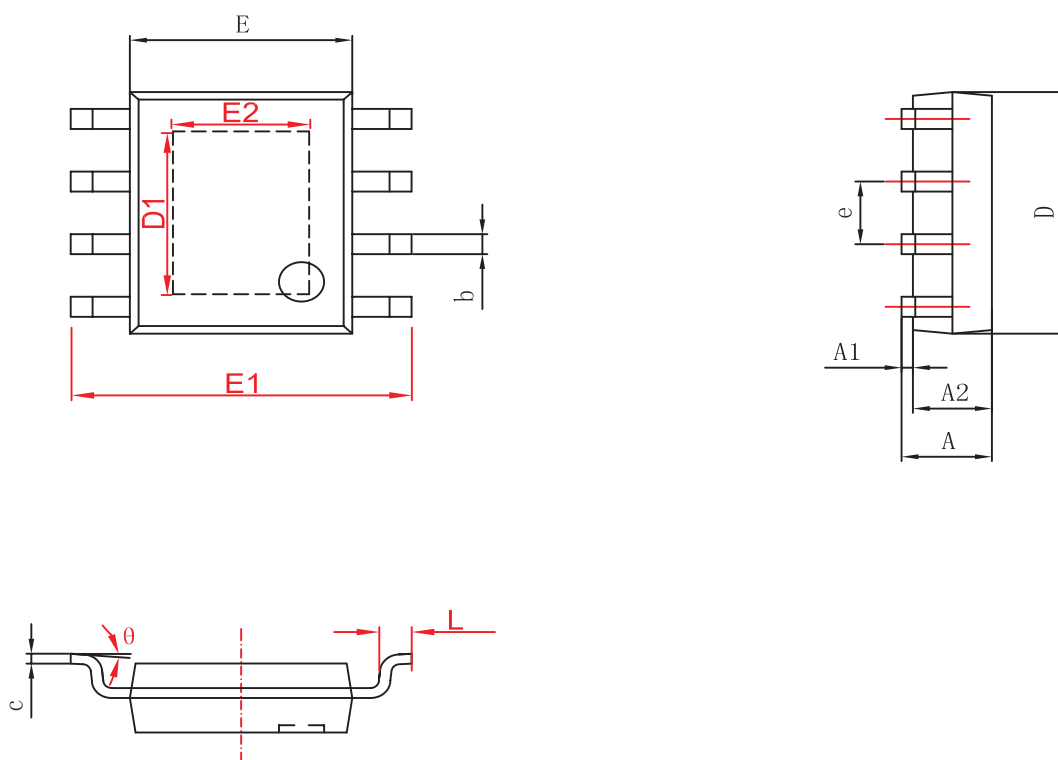
输入电阻和输入电容之间构成了一个高通滤波器，其截止频率如下式：

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_{in} C_{in})}$$

输入电容的值非常重要，一般认为它直接影响着电路的低频性能。无线电话中的喇叭对于低频信号通常不能很好的响应，可以在应用中选择比较大的f_c以滤除217HZ噪声引入的干扰。电容之间良好的匹配对提升芯片的整体性能和Pop & Click的抑制都有帮助,因此要求选取精度为10%或者更小的电容。

封装信息

CS8505E ESOP8L



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

Notes:

- (1) 所有尺寸都为毫米
- (2) 参考JEDEC MO-187标准